

1. Procedeu de obținere a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, care constă în sinterizarea pulberilor de ZnO și Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> într-un volum închis la temperatura de 900...1150°C, sinterizarea se efectuează prin reacții chimice de transport, utilizând HCl în calitate de agent de transport, cu presiunea inițială de 0,101...0,608 MPa, totodată se utilizează pulberi de Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> cu concentrația de 1...5 mol% cu mărimea granulelor nu mai mare de 300 μm pentru obținerea țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl, impuritățile de Cl având concentrația de 1·10<sup>18</sup>...5·10<sup>19</sup> cm<sup>-3</sup>.
2. Procedeu de obținere a straturilor subțiri de ZnO:Ga:Cl la temperaturi scăzute, care constă în vacuumarea camerei magnetronului până la presiunea de 133,32÷666,61·10<sup>-5</sup> Pa, injectarea gazului Ar cu presiunea de 0,00013÷0,0013 MPa, pulverizarea magnetron la temperatura de depunere de 80...300°C a țintelor ceramice de ZnO:Ga:Cl, obținute prin procedeul din rev. 1.